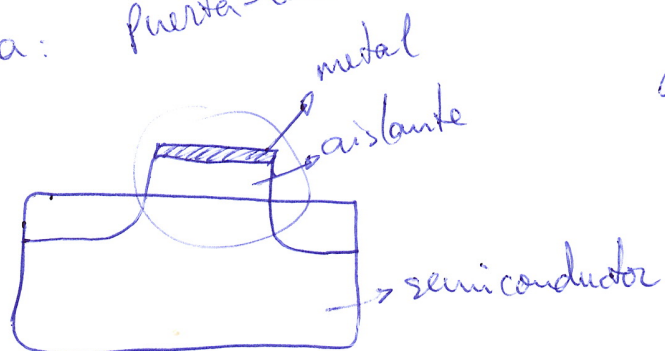




Introducción MOSFET : aptos en CV

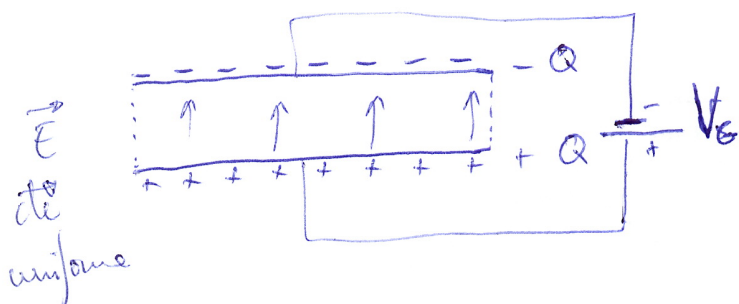
Idea: Puerta-Gate



la puerta es un condensador

Metal - Óxido - Semiconductor - Field - Effect - Transistor

Condensador es la puerta



2 placas conductoras \rightarrow metal

separadas por un
aislante \rightarrow óxido Si
excelente calidad
Si-the King

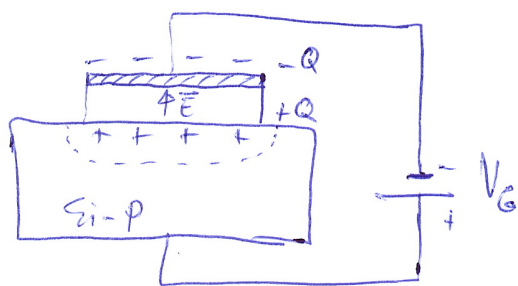
Tenemos la misma carga

en cada placa: Q

la geometría y el aislante definen
su capacidad $C = \epsilon \epsilon_0 \cdot \frac{S}{d}$

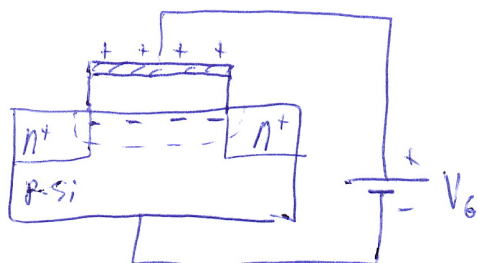
de almacenar carga: $C = \frac{Q}{V}$

Ahora:



si la placa de abajo es sc,
tenemos acumulac carga +, μ_s^+
asociada a la placa + del condensador

mejor:



Voy a poder forzar zona N en

el silicio P a través

volteje en la puerta:

conducción e^- a través canal.

MOS Canal N

V_{th}
ON